

平成 29 年度九州表面・真空研究会 2017 (兼 第 22 回九州薄膜表面研究会)

「新奇的な薄膜・表面現象とその応用の最前線」

平成 29 年 6 月 24 日 (土) 於 佐賀大学本庄キャンパス 大学院棟 301 室

- 8:55 開会の挨拶
- 1、 X線トポグラフィーで観察された(111)CVDダイヤモンド単結晶の転位とエッチピットとの関係
9:00-9:15 (佐賀大院工) ○榎谷 聡士、嘉数 誠
- 2、 Interface properties of diamond MOS structures studied by C-V measurements
9:15-9:30 (Department of Electrical and Electronic Engineering, Saga University)
○Niloy Chandra Saha, Makoto Kasu
- 3、 ZnPc/STO 界面における分子配向と電子状態
9:30-9:45 (佐賀大シンクロトロン) ○宇野哲平、米倉大貴、山本勇、今村真幸、高橋和敏、東純平
- 4、 Ge(111)上に作成した BiV3×V3R30°超構造の角度分解 2 光子光電子分光
9:45-10:00 (佐賀大院工^A、佐賀大シンクロトロン^B)
○松石 紘太郎^A、今村 真幸^B、山本 勇^B、東 純平^B、高橋 和敏^B
- 5、 DCメタンプラズマ CVD を利用したナノダイヤモンド合成に関するシーブ作用
10:00-10:15 (九工大院^A、宇部高専^B、九共大総研^C)
○縄田悠人^A、小林友樹^A、内田和希^A、内藤正路^A、碓智徳^B、生地文也^C、長井達三^C
- 10:15-10:30 **休憩**
- 6、 フッ素化アルキル鎖を用いた撥水性導電酸化グラフェン薄膜の評価
10:30-10:45 (佐賀大院工^A、FLEC,AIST^B) ○大竹亜紗美^A、内野聖子^A、福田伸子^B、坂口幸一^A
- 7、 電位差滴定法を用いた酸化グラフェン表面上に含まれる酸素官能基量の評価
10:45-11:00 (佐賀大院工) ○牛島政也、園田航大、滝澤登、坂口幸一
- 8、 電位差滴定法による親水性炭素材料表面の酸素官能基量評価
11:00-11:15 (佐賀大院工) ○園田航大、牛島政也、松尾大樹、滝澤登、坂口幸一
- 9、 大気圧プラズマ法によって合成した原料粒径の異なる親水化炭素材料薄膜の電気特性
11:15-11:30 (佐賀大院工^A、佐賀大理工^B) ○松尾大樹^A、内野聖子^A、白鳥武^A、柴田晴斗^B、坂口幸一^A
- 11:30-12:30 **昼食**
- 10、 MIES による CuPc/SiC(0001)-(1×1)表面の電子状態観測
12:30-12:45 (宇部高専^A、九工大院生命体^B、広島大ナノデバイス・バイオ融合科学研究所^C、九工大院工^D)
○河村和哉^A、植杉昌平^A、松尾航平^B、村岡幸輔^C、石井純子^B、黒木伸一郎^C、内藤正路^D、碓智徳^A

- 1 1、 アルカリ金属及び酸素吸着した SiC(0001)- (6V3×6V3)R30°表面の電子状態
12:45-13:00 (宇部高専^A、阪大院理^B、広島大ナノデバイス・バイオ融合科学研究所^C、九大院工^D、九工大院工^E) ○碓智徳^A、平山楓^A、中村拓人^B、村岡幸輔^C、田中悟^D、黒木伸一郎^C、内藤正路^E
- 1 2、 機能性金属微粒子シートの作製とその応用
13:00-13:15 (九州大先導物質化学研究所)
○田子森恭平、竹熊晴香、Pangpang Wang、龍崎奏、岡本晃一、玉田薫
- 1 3、 色素増感太陽電池におけるナノ粒子を用いた表面改質によるポリマー触媒の反応活性化
13:15-13:30 (九州大院システム情報科学府)
○坂本大輔、張博辰、徐鉉雄、板垣奈穂、古閑一憲、白谷正治
- 1 4、 a-Si:H 薄膜中の Si ネットワーク秩序性のラマン分光法を用いた評価
13:30-13:45 (九州大院 システム情報科学府)
○田中和真、小島尚、都甲将、山下大輔、徐鉉雄、板垣奈穂、古閑一憲、白谷正治
- 13:45-14:00 **休憩**
- 1 5、 **特別講演**：全ての道は『表面』に通ずる —表面を制する者は科学・工学を制する—
14:00-15:00 (大阪大学) 森田 清三
- 1 6、 BiSb 薄膜・トポロジカル絶縁体の電子的性質、および Shockley 状態との両立
15:00-15:15 (福岡教育大物理、九工大工^A、佐賀大 SL センター^B)
福田克也、倉留天翔、○三谷尚、孫勇^A、高橋和敏^B、大後忠志
- 15:15-15:30 **休憩**
- 1 7、 **招待講演**：放射光解析に基づく量子物質開発 “Materials by design”
15:30-16:15 (高エネルギー加速器研究機構) 組頭 広志
- 1 8、 加熱触媒体を用いて生成した H₂O/H₂ 分解種による Si 基板の低温酸化
16:15-16:30 (九州工大院工学府^A、九州工大若手研究者フロンティア研究アカデミー^B)
○田原 慎一^A、大戸 崇伸^A、片宗 優貴^B、和泉 亮^A
- 1 9、 HWCVD 法により堆積した SiCN 膜の機械的特性評価
16:30-16:45 (九州工大院工学府^A、九州工大若手研究者フロンティアアカデミー^B)
○森寛人^A、片宗優貴^B、和泉亮^A
- 2 0、 5V 級正極 Li(Ni_{0.5}Mn_{1.5})O₄と固体電解質 Li₃PO₄ 界面におけるイオン伝導特性
16:45-17:00 (日本工業大学^A、東北大学^B、東京工業大学^C)
○白木将^A、河底秀幸^B、鈴木竜^B、清水亮太^C、一杉太郎^C